2C10 シリコン表面に担持された単一サイズ白金サブナノクラスター ディスクの特異的触媒特性

(豊田工大¹・コンポン研²) 〇安松久登¹、福井信志²

Catalytic activity specific to uni-size Pt subnano cluster disk constructed on Si surface

(Toyota Tech. Inst.¹ and Genesis Res. Inst., Inc.²) OHisato Yasumatsu¹, Nobuyuki Fukui²

【序】サイズ(構成原子数)が百個程度以下の金属クラスターは直径が1 nm 以下(サブ ナノ空間)であるため、その価電子が支配する化学特性に顕著な量子サイズ効果が表れ る。このようなクラスター固有の特性を活用して新奇な機能を引き出す研究が10 年ほど 前から活発になっている[1]。幅広い機能を得るには、クラスターの電荷・スピンの量や 存在空間を目的に応じて調節する工夫が肝要である。そのためには、クラスターの基板 担持、異種原子や配位子の添加などの電子的相互用作用を通じた制御が有望である。

我々は、単原子層白金クラスター[2,3]とシリコン表面とのサブナノ界面に電子が蓄積 されることを見出した[4,5]。すなわち、半導体のショットキー障壁接合と同様な原理に より、白金クラスターの 5d 電子がシリコンへ移動して、クラスターとシリコン表面との サブナノ界面に形成されたショットキー障壁に電子が蓄積される[5]。そこでは酸化還元 触媒機能が期待できる。すなわち、酸化・還元とは分子の電子捕獲・放出であるため、 豊富な電荷で電荷移動が促進されると、低温での触媒活性や触媒サイクルの繰り返し数 (ターンオーバー頻度)の増加、高い被毒耐性などが期待できる。

本発表では、触媒のベンチマークである CO の熱酸化を取り上げ、シリコン表面に担 持された白金クラスターディクスのサブナノ電荷による特異的な触媒作用を報告する。

【実験】マグネトロンスパッタにより白金クラスターイオンを生成し[2]、四重極質量フ ィルターでサイズ選別した(サイズ領域は1-82、単一サイズクラスターイオンの強度は 100-500 pA)[6,7]。白金原子あたりの衝突エネルギーを 1 eV に設定してシリコン (111)-7x7 表面に衝撃させることで、単一サイズクラスターを同表面に固定した[2]。クラ スターの数密度は 1.2×10¹³ cm⁻²以下であるので、基板上でのクラスターの重なりは無視 できる。高感度昇温脱離質量分析法(TPD)[8]により触媒反応を調べた。同一試料に対 して種々の反応原料濃度で TPD 計測を繰り返すことにより、再現性と信頼性の高いデー タを得た。このクラスターは 673 K でも安定であることを STM 計測で確かめている[9]。

cbs

⁵0¹⁸0⁺強度、

13C16

【結果と考察】図1に、シリコン表面に担 持された Pt₃₀の CO 酸化 TPD スペクトルの ¹³C¹⁶O 暴露量に対する依存性を示す。白金 単結晶(111)表面での同反応との比較によ りラングミュアー - ヒンシェルウッド機構 と結論した。すなわち、130 K では負イオ ン様酸素分子、270 K で解離吸着した酸素 原子が吸着 CO と反応して CO, が生成され る。解離吸着酸素原子の寄与は¹³C¹⁶O暴露 量が0.05Lで飽和するが、負イオン様酸素 分子の寄与は2L程度まで増加する。実際 に、図2に示すとおり、負イオン様酸素分 子の反応分岐比は¹³C¹⁶O暴露量が2Lまで 増加している。サブナノ界面の負電荷が負 イオン様酸素分子の活性効率を高めている と考えられる。この他、このクラスター触 媒は、高い CO 被毒耐性を持つことも明ら かとなった。



図1:シリコン表面に担持された Pt₃₀ディスクで 進行する CO の酸化反応における昇温脱離スペ クトル。¹⁸O₂暴露量は2Lに固定した。



図2:シリコン表面に担持された Pt_{30} ディスクの CO酸化触媒における負イオン様酸素分子の反応分岐比。 $^{18}O_2$ 暴露量は2Lに固定した。

参考文献

- [1] 'Nanocatalysis', ed. by U. Heiz and U. Landman, Springer-Verlag (2007).
- [2] H. Yasumatsu et al. J. Chem. Phys. 123, 124709/1-9 (2005).
- [3] H. Yasumatsu et al. J. Chem. Phys. 124, 014701/1-7 (2006).
- [4] H. Yasumatsu et al. Chem. Phys. Lett. 487, 279-284 (2010).
- [5] H. Yasumatsu et al. Phys. Stat. Solidi B 6, 1193-1198 (2012).
- [6] H. Yasumatsu, Euro. Phys. J. D 63, 195-200 (2011).
- [7] H. Yasumatsu and N. Fukui, J. Phys. Conf. Ser. 438, 012004/1-8 (2013).
- [8] H. Yasumatsu et al. J. Phys. Conf. Ser. 185, 012057/1-4 (2009).
- [9] N. Fukui and H. Yasumatsu, Euro. J. Phys. D 67, 81/1-4 (2013).